

6.2. TRANSFORMATORY STERUJĄCE DO TRANZYSTORÓW MOCY

W tym rozdziale przedstawiamy nową serię transformatorów odpowiednich do sterowania pracujących z dużą częstotliwością tranzystorów MOSFET, IGBT itp. Z uwagi na różnicę w sposobie sterowania firmy Sirio jest w stanie wykonać transformatory zgodnie z wymaganiami klienta. Typowe modele zamieszczamy poniżej.



Typ	n	f _{udt} [μVs]	I _p R _{MS} [mA]	L _p [mH]	L _s [μH]	C _k [pF]	R _p [mΩ]	R _s [mΩ]	U _{is} [V AC]	U _{is} / STD [V AC]	U _p [kV]	Obudowa	Schemat
TI/105 630	1:1	5	400	0,04	0,18	9	20	48	700	440 / IEC742	4	105	G
TI/105 645	1:1,25:1,25	5	400	0,04	0,15	10	20	60	700	440 / IEC742	4	105	H
TI/109 217	1:1	200	350	1,75	5	25	320	260	440	440 / IEC742	3,75	109	C
TI/109 221	1:1:1	60	500	0,3	0,8	20	70	160	500	500 / IEC742	4,4	109	B
TI/109 204	1:1:1	120	300	0,85	2	14	250	450	700	440 / IEC742	4,2	109	B
TI/109 220	1:1:1	170	300	1,85	2,5	20	410	480	440	440 / IEC950	3,1	109	B
TI/109 210	1:1:1	250	300	2,5	5	25	500	650	330	330 / IEC742	3,1	109	A
TI/109 205	1:1,3	60	300	0,22	1,2	11	120	180	700	700 / IEC742	5	109	C
TI/109 202	1:1,3+1,3	60	100	0,21	1,6	11	120	280	700	700 / IEC742	5	109	A
TI/109 215	1:1,2+1,2	150	250	1,3	3	20	430	510	500	500 / IEC950	4	109	B
TI/109 213	1,13:1:1	180	250	1,85	4	20	520	450	500	500 / IEC950	4	109	B
TI/109 214	1,4:1:1	200	250	2,15	4	20	550	400	500	500 / IEC950	4	109	B
TI/117 610	1:1	150	600	0,35	0,9	25	120	135	700	700 / IEC950	4	117	D
TI/117 110	1:1	300	200	3,5	5	35	800	800	500	500 / IEC950	4	117	D
TI/117 615	1:1:1	150	600	0,35	0,6	40	120	150	700	700 / IEC950	4	117	E
TI/117 120	1:1:1	300	200	3,5	2,2	35	800	800	500	500 / IEC950	4	117	E
TI/117 147	2:1	250	400	5,8	10	25	500	250	500	500 / IEC950	4	117	D
TI/117 155	2:1:1	250	400	5,8	8,5	25	500	250	500	500 / IEC950	4	117	E
TI/117 263	3:1	200	130	1,6	3	22	160	70	500	500 / IEC950	3,2	117	F

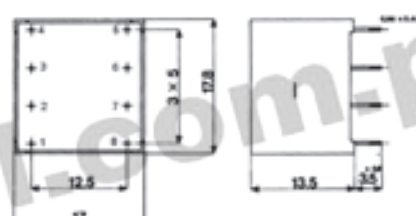
Uwaga

n	przekładnia transformatora	R _p /R _s	rezystancja uzwojenia pierwotnego/wtórnego
L _p	indukcyjność uzwojenia pierwotnego	U _{is}	napięcie pracy
C _k	pojemność sprzężenia pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym połączonymi razem	U _p	napięcie probiercze
L _s	indukcyjność rozproszenia uzwojenia pierwotnego odniesiona do wtórnego w stanie zwarcia	f _{udt}	minimalna wartość wypełnienia impulsu napięciowego transformowanego na stronę wtórną w impulsie unipolarnym

Obudowa 117



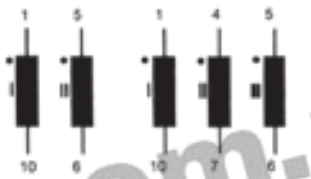
Obudowa 109



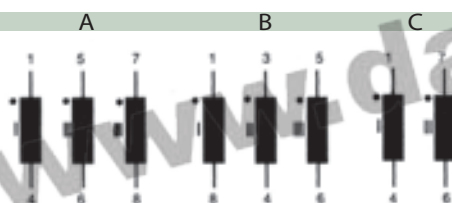
Obudowa 105



Obudowa G



Schemat



Schemat

